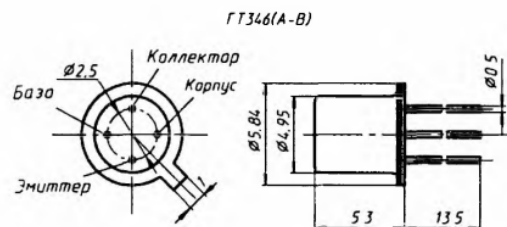


ГТЗ46А, ГТЗ46Б, ГТЗ46В

Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные с нормированным коэффициентом шума на частотах 800 и 200 МГц. Предназначены для применения в селекторах телевизионных каналов метрового и дециметрового диапазонов длин волн с автоматической регулировкой усиления. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА:

$T = +25^\circ\text{C}$:	
ГТЗ46А, ГТЗ46Б	10...150
ГТЗ46В	15...150
$T = -45^\circ\text{C}$:	
ГТЗ46А, ГТЗ46Б	3,5...150
ГТЗ46В	5...150
$T = +55^\circ\text{C}$:	
ГТЗ46А, ГТЗ46Б	10...450
ГТЗ46В	15...450

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА, не менее:

ГТЗ46А	700 МГц
ГТЗ46Б, ГТЗ46В	550 МГц

Постоянная времени обратной связи при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА, $f = 100$ МГц, не более:

ГТЗ46А	3 пс
ГТЗ46Б	5,5 пс
ГТЗ46В	6 пс

Коэффициент шума при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА, $R_c = 75$ Ом, не более:

$f = 800$ МГц для ГТЗ46А	6 дБ
$f = 800$ МГц для ГТЗ46Б	8 дБ
$f = 200$ МГц для ГТЗ46В	7 дБ

Коэффициент усиления по мощности при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА, $f = 800$ МГц, не менее ..

Оптимальный ток эмиттера, соответствующий $K_{у,р} = K_{у,р, макс}$ при $U_{кб} = 10$ В, $f = 800$ МГц для ГТЗ46А, ГТЗ46В

Глубина регулирования коэффициента усиления по мощности при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 2...8$ мА, $f = 800$ МГц для ГТЗ46А, ГТЗ46В, не менее

Коэффициент обратного усиления по мощности при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА, $f = 800$ МГц, не менее:

ГТЗ46А	20 дБ
ГТЗ46В	12 дБ

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 20$ В, не более:

$T = +25^\circ\text{C}$	10 мкА
$T = +55^\circ\text{C}$	100 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 0,3$ В, не более

Емкость коллекторного перехода

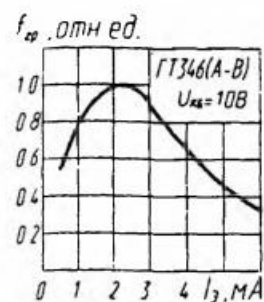
при $U_{кб} = 5$ В, не более

Предельные эксплуатационные данные

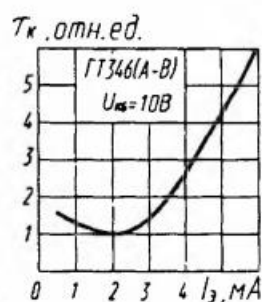
Постоянное напряжение коллектор—база	20 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
при $R_{бз} = 0$	15 В
при $R_{бз} = 5$ кОм	20 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	0,3 В
Постоянный ток коллектора	10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	50 мВт
Температура <i>p-n</i> перехода	+85 °С
Температура окружающей среды	-45...+55 °С

Изгиб выводов транзисторов допускается не ближе 1,5 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Растягивающая выводы сила не должна превышать 2,5 Н (0,25 кгс).

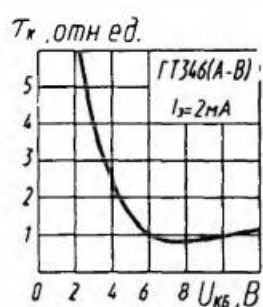
Минимальное расстояние от места пайки вывода до корпуса 2 мм при температуре пайки не выше $+260\text{ }^{\circ}\text{C}$ и длительности не более 2 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать $+235\text{ }^{\circ}\text{C}$.



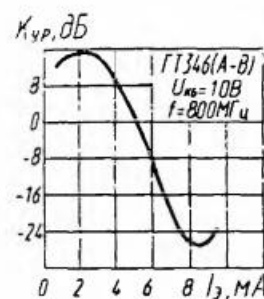
Зависимость граничной частоты от тока эмиттера



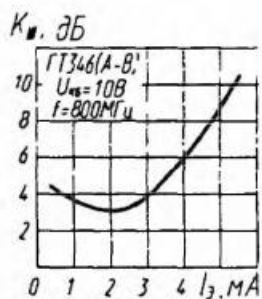
Зависимость постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера



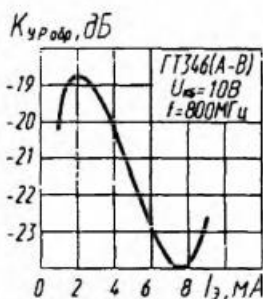
Зависимость постоянной времени цепи обратной связи от напряжения коллектор—база



Зависимость коэффициента усиления от тока эмиттера



Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера



Зависимость коэффициента усиления от тока эмиттера